



Doppeldiffundierte SILIZIUMDIODE

zur Verwendung als Klemmdiode
in Farbfernsehempfängern

Mechanische Daten:

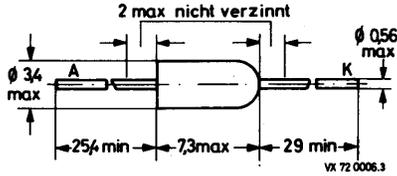
Gehäuse: Kunststoff
JEDEC DO-14

Das Kunststoffgehäuse erfüllt die Kurzprüfung "Feuchte Wärme" nach DIN 40 046 bzw. IEC 68 - 2D.

Maßangaben in mm.

Lötung:

max. Löttdauer 3 s bei einer Löttemperatur von max. 300°C, die Lötstellen müssen min. 5 mm vom Gehäuse entfernt sein.
Das Kunststoffgehäuse darf an etwaigen Berührungsstellen nicht heißer als 125°C werden.



Kurzdaten:

Scheitelsperrspannung	$U_{RWM} = \text{max. } 300 \text{ V}$
Spitzensperrspannung	$U_{RM} = \text{max. } 350 \text{ V}$
Durchlaßstrom, Mittelwert	$I_{FAV} = \text{max. } 300 \text{ mA}$
Durchlaßstrom, Scheitelwert	$I_{FM} = \text{max. } 2 \text{ A}$
Sperrschichttemperatur	$\vartheta_J = \text{max. } 125 \text{ }^\circ\text{C}$
Durchlaßspannung bei $I_F = 100 \text{ mA}$, $\vartheta_J = 75 \text{ }^\circ\text{C}$	$U_F \leq 1 \text{ V}$
Sperrstrom bei $U_R = 300 \text{ V}$, $\vartheta_J = 75 \text{ }^\circ\text{C}$	$I_R \leq 10 \text{ } \mu\text{A}$
Sperrverzugsladung beim Umschalten von $I_F = 10 \text{ mA}$ auf $U_R = 2 \text{ V}$	$Q_S \leq 0,4 \text{ nAs}$

Absolute Grenzwerte:

Scheitelsperrspannung:	$U_{RWM} = \text{max. } 300 \text{ V}$
Spitzensperrspannung:	$U_{RM} = \text{max. } 350 \text{ V}$
Spannungsstoß in Sperrrichtung:	$u_{R \text{ stoß}} = \text{max. } 350 \text{ V} \quad 1)$
Durchlaßstrom, Mittelwert:	$I_{F AV} = \text{max. } 300 \text{ mA} \quad 2)$
Durchlaßstrom, Scheitelwert:	$I_{FM} = \text{max. } 2 \text{ A} \quad 3)$
Überlastungs-Stromstoß:	$i_{F \text{ stoß}} = \text{max. } 15 \text{ A} \quad 4)$
negativer Spitzenstrom:	$I_{RM} = \text{max. } 500 \text{ mA}$
Sperrschichttemperatur:	$\vartheta_J = \text{max. } 125 \text{ }^\circ\text{C}$
Lagerungstemperatur:	$\vartheta_S = \text{min. } -65 \text{ }^\circ\text{C}$
	$\vartheta_S = \text{max. } 125 \text{ }^\circ\text{C}$

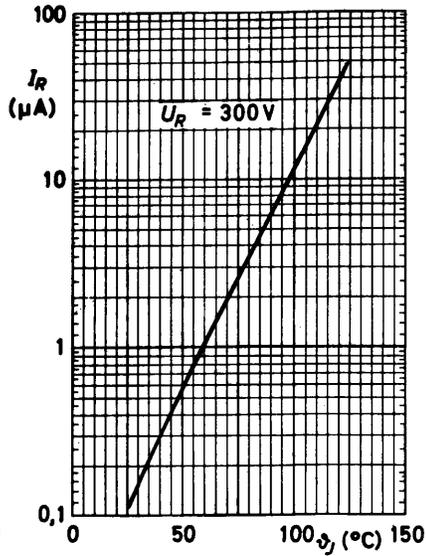
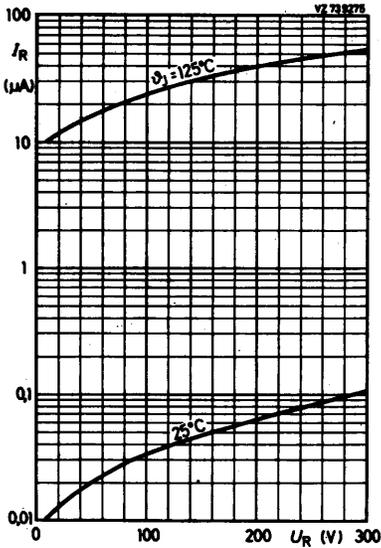
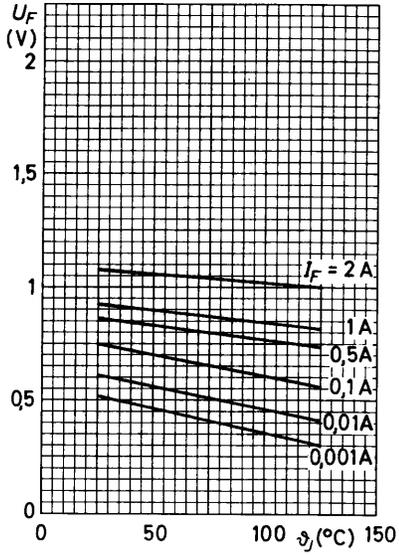
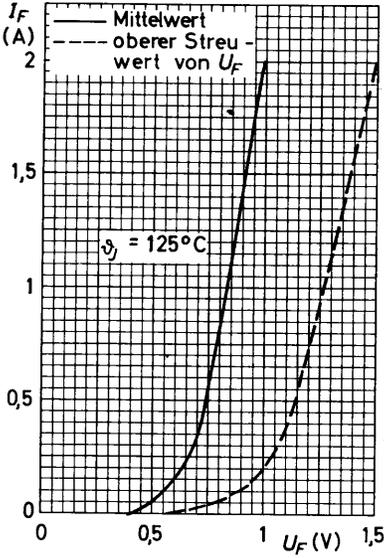
Wärmewiderstand:

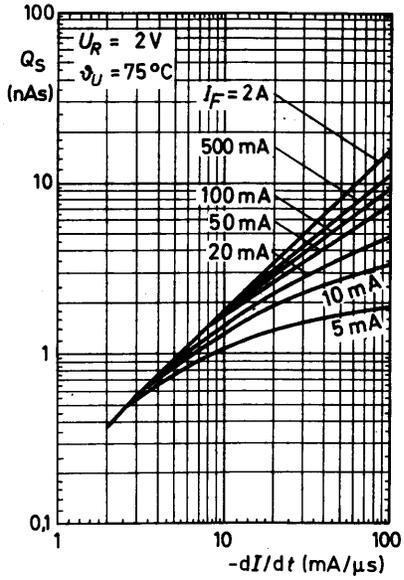
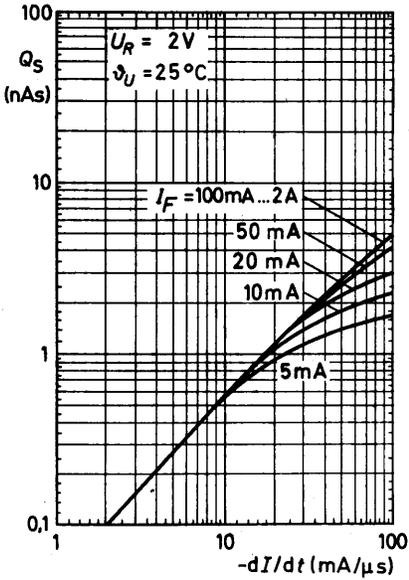
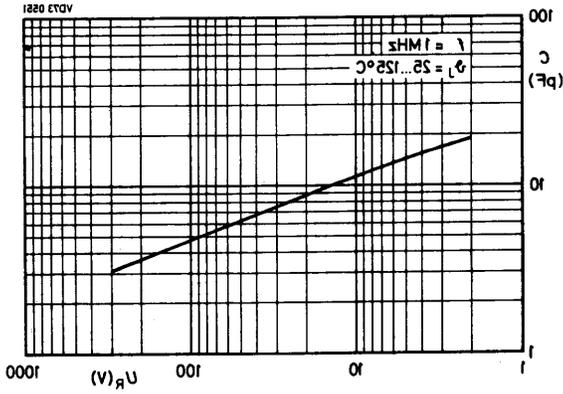
zwischen Sperrschicht und Umgebung:	$R_{th U} \leq 0,2 \text{ K/mW}$
-------------------------------------	----------------------------------

Kennwerte:

Durchlaßspannung bei $I_F = 100 \text{ mA}$, $\vartheta_J = 75^\circ\text{C}$:	$U_F \leq 1 \text{ V}$
Sperrstrom bei $U_R = 300 \text{ V}$, $\vartheta_J = 25^\circ\text{C}$:	$I_R \leq 2 \text{ } \mu\text{A}$
bei $U_R = 300 \text{ V}$, $\vartheta_J = 75^\circ\text{C}$:	$I_R \leq 10 \text{ } \mu\text{A}$
Kapazität bei $U_R = 150 \text{ V}$, $f = 1 \text{ MHz}$, $\vartheta_J = 25 \dots 125^\circ\text{C}$:	$C = 4 \text{ pF}$
Sperrverzugsladung beim Umschalten von $I_F = 10 \text{ mA}$ auf $U_R = 2 \text{ V}$ mit $-dI/dt = 5 \text{ mA}/\mu\text{s}$ bei $\vartheta_J = 25^\circ\text{C}$:	$Q_S \leq 0,4 \text{ nAs}$

- 1) max. Dauer $t = 1 \text{ ms}$
- 2) max. Integrationszeit $t_{av} = \text{max. } 20 \text{ ms}$
- 3) Spitzenwert $I_{FM} = \text{max. } 5 \text{ A}$ bei $t \leq 10 \text{ } \mu\text{s}$
- 4) max. Dauer $t = 10 \text{ ms}$ (Sinushalbwellen)





**Doppeldiffundierte****SILIZIUMDIODE**

für schnelle Schalteranwendungen,
z.B. als Phasenvergleichsdiode für
Horizontalablenkung oder als Klemm-
diode in Fernsehempfängern sowie
für Gleichrichteranwendungen

Mechanische Daten:

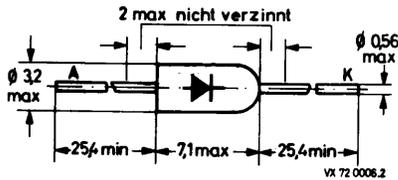
Gehäuse: Kunststoff, JEDEC D0-14

Das Kunststoffgehäuse
erfüllt die Kurzprüfung
"Feuchte Wärme"
nach DIN 40 046
bzw. IEC 68-2D.

Maßangaben in mm.

Lötung:

max. Löttdauer 3 s bei
einer Löttemperatur
von 300°C, die Lötstellen
müssen min. 5 mm vom
Gehäuse entfernt sein.
Das Kunststoffgehäuse
darf an etwaigen Berührungs-
stellen nicht heißer als
125°C werden.

**Kurzdaten:**

Scheitelsperrspannung

$U_{RWM} = \text{max. } 300 \text{ V}$

Spitzensperrspannung

$U_{RM} = \text{max. } 350 \text{ V}$

Durchlaßstrom, Mittelwert bei $U_{RWM} = 300 \text{ V}$

$I_{FAV} = \text{max. } 400 \text{ mA}$

bei $U_{RWM} = 80 \text{ V}$

$I_{FAV} = \text{max. } 500 \text{ mA}$

Durchlaßstrom, Scheitelwert

$I_{FM} = \text{max. } 3 \text{ A}$

Sperrschichttemperatur

$\vartheta_J = \text{max. } 150 \text{ }^\circ\text{C}$

Durchlaßspannung bei $I_F = 2 \text{ A}$, $\vartheta_J = 150 \text{ }^\circ\text{C}$

$U_F \leq 1,5 \text{ V}$

Sperrstrom bei $U_R = 300 \text{ V}$, $\vartheta_J = 125 \text{ }^\circ\text{C}$

$I_R \leq 200 \text{ } \mu\text{A}$

Absolute Grenzwerte:

Scheitelsperrspannung:

Spitzensperrspannung ($V_T \leq 0,01$):

Spannungsstoß in Sperrichtung ($t = \max. 10 \text{ ms}$):

Durchlaßstrom, Mittelwert bei $U_{RWM} \leq 300 \text{ V}$:
 bei $U_{RWM} \leq 80 \text{ V}$:

Durchlaßstrom, Scheitelwert:

Überlastungs-Stromstoß ($t = \max. 10 \text{ ms}$): ²⁾

negativer Spitzenstrom:

Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

U_{RWM}	= max.	300 V
U_{RM}	= max.	350 V
$u_{R \text{ stoß}}$	= max.	350 V
$I_{F AV}$	= max.	400 mA
$I_{F AV}$	= max.	500 mA
I_{FM}	= max.	3 A ¹⁾
$i_{F \text{ stoß}}$	= max.	15 A
I_{RM}	= max.	500 mA
ϑ_J	= max.	150 °C
ϑ_S	= min.	-65 °C
ϑ_S	= max.	125 °C

Wärmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Umgebung,

bei Befestigung an Lötflächen, volle Drahtlänge: $R_{th U} \leq 200 \text{ grad/W}$

bei Befestigung an Lötflächen, Drahtlänge je 10 mm: $R_{th U} \leq 150 \text{ grad/W}$

bei Befestigung auf Leiterplatte mit kleinen Kupferflächen, Drahtlänge je > 5 mm: $R_{th U} \leq 200 \text{ grad/W}$

Kennwerte:

Durchlaßspannung bei $I_F = 2 \text{ A}$, $\vartheta_J = 150^\circ\text{C}$: $U_F \leq 1,5 \text{ V}$

Sperrstrom bei $U_R = 300 \text{ V}$, $\vartheta_J = 25^\circ\text{C}$: $I_R \leq 2 \mu\text{A}$

bei $U_R = 300 \text{ V}$, $\vartheta_J = 125^\circ\text{C}$: $I_R \leq 200 \mu\text{A}$

Kapazität

bei $U_R = 150 \text{ V}$, $f = 1 \text{ MHz}$, $\vartheta_J = 25 \dots 125^\circ\text{C}$: $C = 4 \text{ pF}$

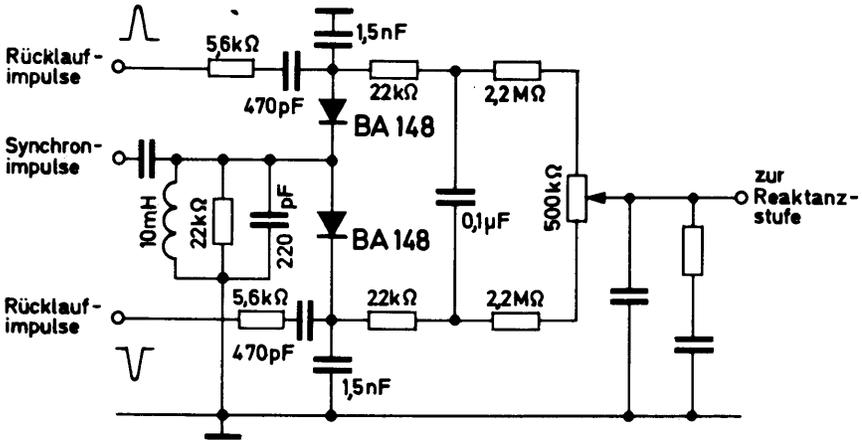
Sperrverzugsladung

beim Umschalten von $I_F = 10 \text{ mA}$ auf $U_R = 2 \text{ V}$
 mit $-dI/dt = 5 \text{ mA}/\mu\text{s}$ bei $\vartheta_J = 25^\circ\text{C}$: $Q_S \leq 0,8 \text{ nC}$

1) Spitzenwert $I_{FM} = \max. 5 \text{ A}$ bei $t \leq 10 \mu\text{s}$

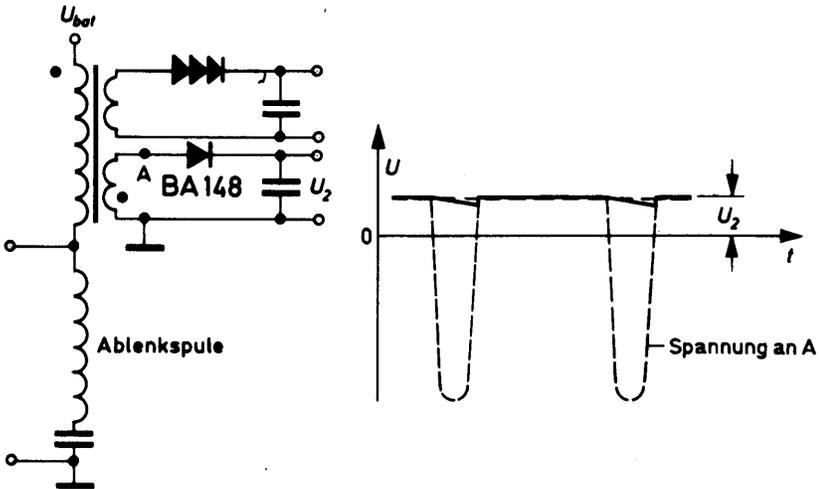
2) sinusförmige Stromhalbwellen, $\vartheta_J = 125^\circ\text{C}$

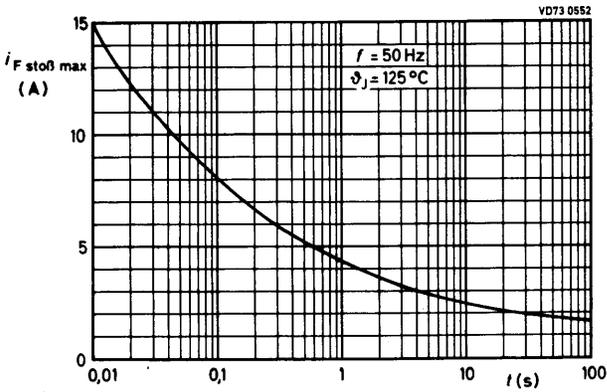
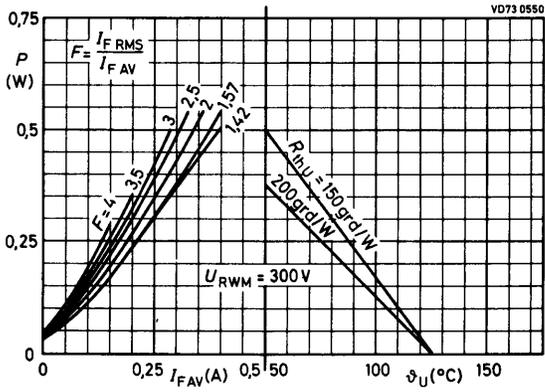
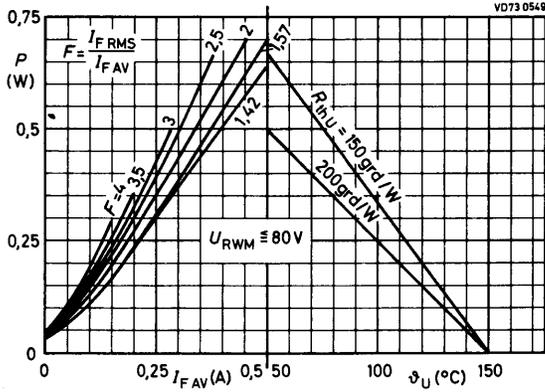
Phasenvergleichsschaltung:

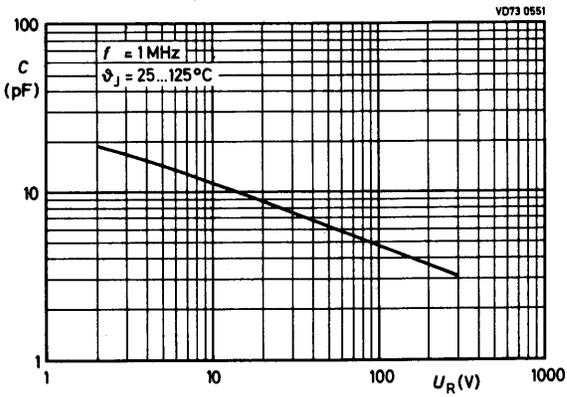
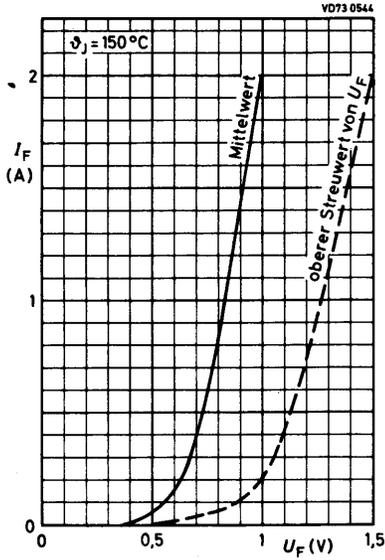


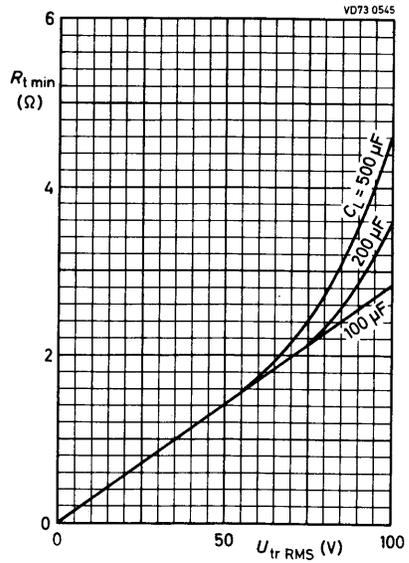
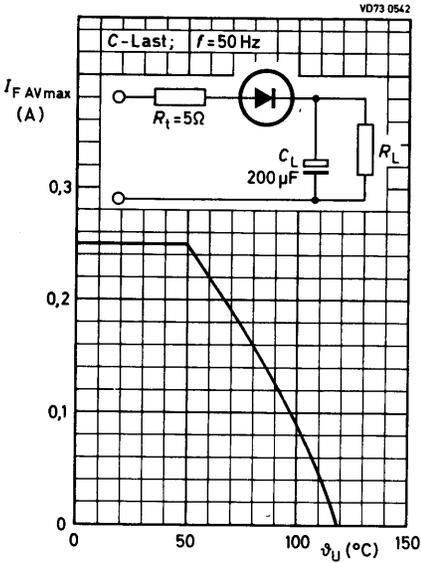
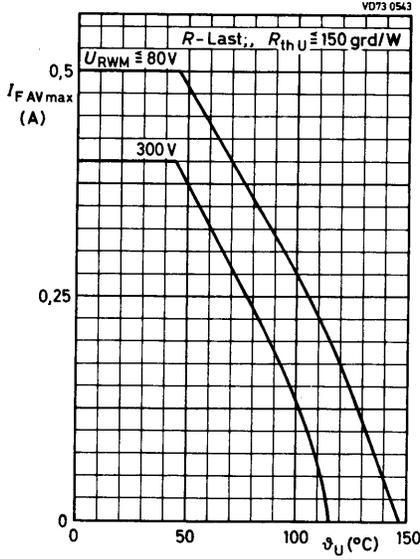
Gleichrichterschaltung

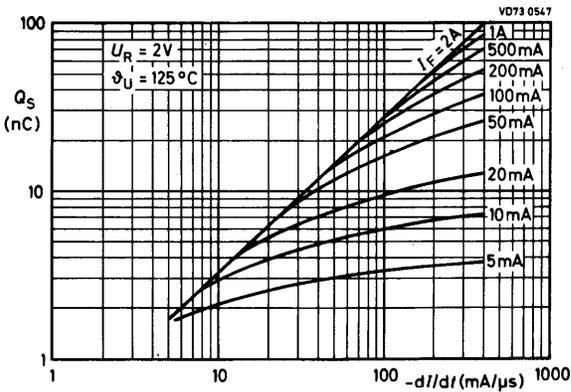
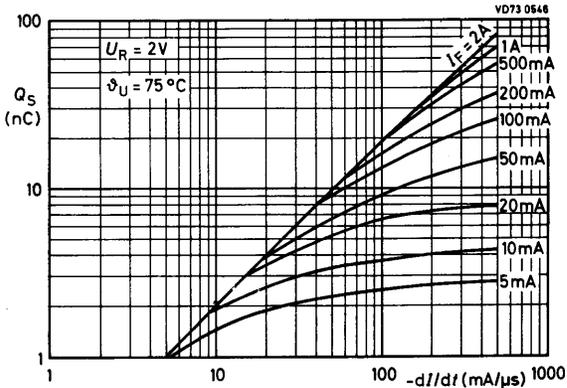
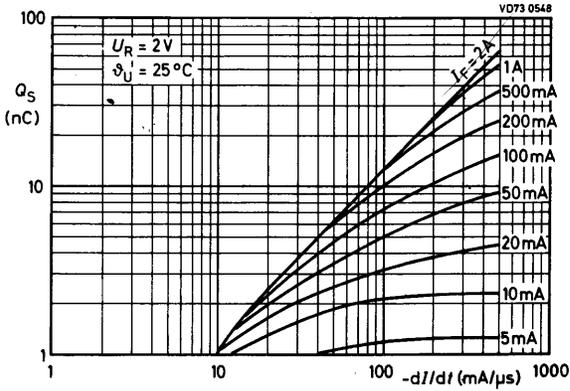
für Ausgangsspannungen bis ca. 30 V aus der Hinlaufspannung













BA 220

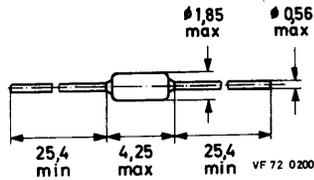
**SILIZIUM - PLANAR - EPITAXIAL -
STABILISIERUNGSDIODE (STABISTOR)**
zur Stabilisierung kleiner Spannungen
sowie für Begrenzer- und Schutzschaltungen

Mechanische Daten:

Gehäuse: Glas, JEDEC DO-35

Farbcodierung:

- 1. Farbstreifen (breit, Katodenseite): rot
- 2. Farbstreifen: rot
- 3. Farbstreifen: schwarz



Maßangaben in mm.

Kurzdaten:

Sperrspannung, Scheitelwert:	U_{RM}	= max.	10	V
Durchlaßstrom, Scheitelwert:	I_{FM}	= max.	400	mA
Sperrschichttemperatur:	ϑ_J	= max.	200	°C
Durchlaßspannung bei $I_F = 10$ mA, $\vartheta_J = 25^\circ\text{C}$:	U_F	=	680-750	mV
Sperrstrom bei $U_R = 10$ V, $\vartheta_J = 25^\circ\text{C}$:	I_R	\leq	1,5	μA

BA 220

Absolute Grenzwerte: (gültig bis ϑ_J max)

Sperrspannung, Scheitelwert:

$$U_{RM} = \text{max. } 10 \text{ V}$$

Durchlaßstrom, Mittelwert ($t_{av} = \text{max. } 20 \text{ ms}$):

$$I_{F AV} = \text{max. } 200 \text{ mA } ^1)$$

Durchlaßstrom, Scheitelwert:

$$I_{FM} = \text{max. } 400 \text{ mA}$$

Überlastungs-Stromstoß, $t = 1 \mu\text{s}$:

$$i_{F \text{ stoß}} = \text{max. } 4 \text{ A}$$

$t = 1 \text{ s}$:

$$i_{F \text{ stoß}} = \text{max. } 1 \text{ A}$$

Sperrschichttemperatur:

$$\vartheta_J = \text{max. } 200 \text{ } ^\circ\text{C}$$

Lagerungstemperatur:

$$\vartheta_S = \text{min. } -65 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$\vartheta_S = \text{max. } 200 \text{ } ^\circ\text{C}$$

Wärmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Umgebung:

$$R_{th U} \leq 0,5 \text{ K/mW}$$

Kennwerte: (bei $\vartheta_J = 25^\circ\text{C}$)

Durchlaßspannung

bei $I_F = 0,1 \text{ mA}$: $U_F = 460-520 \text{ mV}$

bei $I_F = 1 \text{ mA}$: $U_F = 560-620 \text{ mV}$

bei $I_F = 5 \text{ mA}$: $U_F = 640-700 \text{ mV}$

bei $I_F = 10 \text{ mA}$: $U_F = 680-750 \text{ mV}$

bei $I_F = 100 \text{ mA}$: $U_F = 825-950 \text{ mV}$

Sperrstrom

bei $U_R = 10 \text{ V}$: $I_R \leq 1,5 \mu\text{A}$

Kleinsignalkapazität

bei $U_R = 0$

und $f = 1 \text{ MHz}$: $C \leq 2,5 \text{ pF}$

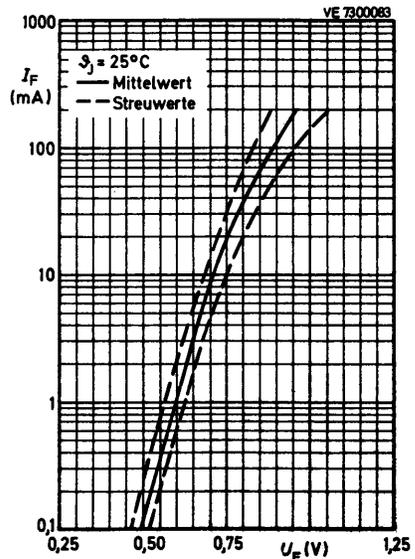
Sperrverzögerungszeit

beim Umschalten von $I_F = 10 \text{ mA}$

auf $U_R = 6 \text{ V}$ ($R_L = 100 \Omega$),

gemessen bei $i_R = 1 \text{ mA}$:

$$t_{rr} \leq 4 \text{ ns}$$



¹⁾ bei sinusförmigem Stromverlauf
max. 130 (= $400/\pi$) mA



BA 221

SILIZIUM - PLANAR - EPITAXIAL - ALLZWECKDIODE

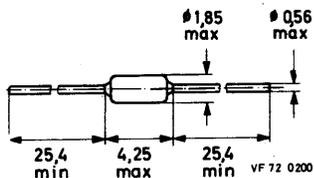
Mechanische Daten:

Gehäuse: Glas, JEDEC DO-35

Farbcodierung:

- 1. Farbstreifen (breit, Katodenseite): rot
- 2. Farbstreifen: rot
- 3. Farbstreifen: braun

Maßangaben in mm.



Kurzdaten:

Sperrspannung:	U_R	= max.	30	V
Durchlaßstrom, Scheitelwert:	I_{FM}	= max.	400	mA
Sperrschichttemperatur:	ϑ_J	= max.	200	°C
Durchlaßspannung bei $I_F = 100$ mA, $\vartheta_J = 25^\circ\text{C}$:	U_F	\leq	950	mV
Sperrstrom bei $U_R = 30$ V, $\vartheta_J = 25^\circ\text{C}$:	I_R	\leq	200	nA

BA 221

Absolute Grenzwerte: (gültig bis $\vartheta_J \text{ max}$)

Sperrspannung:

Durchlaßstrom, Mittelwert ($t_{av} = \text{max. } 20 \text{ ms}$):

Durchlaßstrom, Scheitelwert:

Überlastungs-Stromstoß, $t = 1 \mu\text{s}$:

$t = 1 \text{ s}$:

Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

U_R	= max.	30 V
$I_{F \text{ AV}}$	= max.	200 mA ¹⁾
$I_{F \text{ M}}$	= max.	400 mA
$i_{F \text{ stoß}}$	= max.	4 A
$i_{F \text{ stoß}}$	= max.	1 A
ϑ_J	= max.	200 °C
ϑ_S	= min.	-65 °C
ϑ_S	= max.	200 °C

Wärmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Umgebung:

$$R_{th \text{ U}} \leq 0,5 \text{ K/mW}$$

Kennwerte: (bei $\vartheta_J = 25^\circ\text{C}$)

Durchlaßspannung

bei $I_F = 1 \text{ mA}$: $U_F \leq 625 \text{ mV}$

bei $I_F = 100 \text{ mA}$: $U_F \leq 950 \text{ mV}$

bei $I_F = 200 \text{ mA}$: $U_F \leq 1050 \text{ mV}$

Sperrstrom

bei $U_R = 10 \text{ V}$: $I_R \leq 25 \text{ nA}$

bei $U_R = 30 \text{ V}$: $I_R \leq 200 \text{ nA}$

Kleinsignalkapazität

bei $U_R = 0$

und $f = 1 \text{ MHz}$: $C \leq 2,5 \text{ pF}$

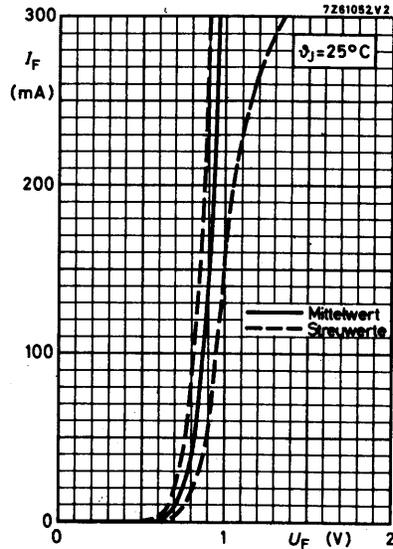
Sperrverzögerungszeit

beim Umschalten von $I_F = 10 \text{ mA}$

auf $U_R = 6 \text{ V}$ ($R_L = 100 \Omega$),

gemessen bei $i_R = 1 \text{ mA}$:

$$t_{rr} \leq 4 \text{ ns}$$



¹⁾ bei sinusförmigem Stromverlauf
max. 130 (= $400/\pi$) mA

SILIZIUM - PLANAR - EPITAXIAL - DIODE
für Ratiidetektor-Schaltungen

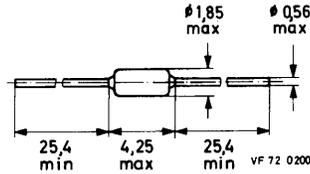
Mechanische Daten:

Gehäuse: Glas, JEDEC D0-35

Farbcodierung:

- 1. Farbring (breit, Katode): rot
- 2. Farbring: grau
- 3. Farbring: braun

Maßangaben in mm.



Kurzdaten:

Sperrspannung	$U_R = \text{max. } 50 \text{ V}$
Durchlaßstrom	$I_F = \text{max. } 200 \text{ mA}$
Sperrschichttemperatur	$\vartheta_J = \text{max. } 200 \text{ }^\circ\text{C}$
Durchlaßspannung bei $I_F = 10 \mu\text{A}$	$U_F = 360 \dots 420 \text{ mV}$
Sperrstrom bei $U_R = 50 \text{ V}$	$I_R \leq 50 \text{ nA}$

BA 281

Absolute Grenzwerte:

Gleichsperrspannung:

$$U_R = \text{max. } 50 \text{ V}$$

Durchlaß-Gleichstrom:

$$I_F = \text{max. } 200 \text{ mA}$$

Durchlaßstrom, Spitzenwert:

$$I_{FM} = \text{max. } 450 \text{ mA}$$

Sperrschichttemperatur:

$$\vartheta_J = \text{max. } 200 \text{ }^\circ\text{C}$$

Lagerungstemperatur:

$$\vartheta_S = \text{min. } -65 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$\vartheta_S = \text{max. } 200 \text{ }^\circ\text{C}$$

Wärmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Umgebung:

$$R_{th U} \leq 0,6 \text{ K/mW}$$

Statische Kennwerte: bei $\vartheta_J = 25^\circ\text{C}$

Durchlaßspannung bei $I_F = 10 \text{ } \mu\text{A}$:

$$U_F = 360 \dots 420 \text{ mV}$$

bei $I_F = 100 \text{ mA}$:

$$U_F \leq 1,0 \text{ V}$$

Sperrstrom bei $U_R = 50 \text{ V}$:

$$I_R \leq 50 \text{ nA}$$

Dynamische Kennwerte:

Kapazität bei $U_R = 0$, $f = 1 \text{ MHz}$:

$$C \leq 1,2 \text{ pF}$$

HF-Gleichrichtung

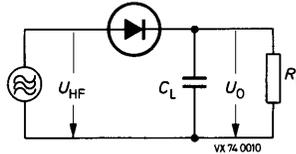
bei $f = 10,7 \text{ MHz}$, $R_L = 33 \text{ k}\Omega$, $C_L = 330 \text{ pF}$ und $U_{HF M} = 3 \text{ V}$:

Spannungsrichtverhältnis:

$$U_O / U_{HF M} = 0,85$$

Dämpfungswiderstand:

$$r_d = 12 \text{ k}\Omega$$





BA 315

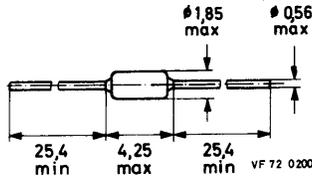
SILIZIUM - PLANAR - EPITAXIAL -
STABILISIERUNGSDIODE (STABISTOR)
zuß Stabilisierung kleiner Spannungen
sowie für Begrenzer- und Schutzschaltungen

Mechanische Daten:

Gehäuse: Glas, JEDEC DO-35

Farbcodierung:

1. Farbstreifen (breit, Katode): orange
2. Farbstreifen: braun
3. Farbstreifen: grün



Maßangaben in mm.

Kurzdaten:

Sperrspannung, Scheitelwert	$U_{R M} = \max.$	5	V
Durchlaßstrom, Scheitelwert	$I_{F M} = \max.$	225	mA
Sperrschichttemperatur	$\vartheta_J = \max.$	200	°C
Durchlaßspannung bei $I_F = 100 \mu A$	$U_F =$	480...540	mV
bei $I_F = 100 mA$	$U_F =$	875...1050	mV
Sperrstrom bei $U_R = 5 V$	$I_R <$	1,5	μA

VALVO HALBLEITERDIODEN

9,74
201

BA 480

SILIZIUM - EPITAXIAL - SCHOTTKY-BARRIER - DIODE

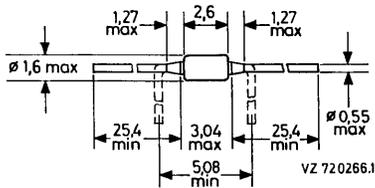
zur Verwendung als UHF-Mischdiode

Mechanische Daten:

Gehäuse: Glas, JEDEC D0-34

Die Katodenseite ist durch einen Farbring gekennzeichnet.

Maßangaben in mm.



Kurzdaten:

Sperrspannung

$U_R = \text{max. } 4 \text{ V}$

Durchlaßstrom

$I_F = \text{max. } 30 \text{ mA}$

Sperrschichttemperatur

$\vartheta_J = \text{max. } 100 \text{ }^\circ\text{C}$

Rauschzahl bei $I_F = 2 \text{ mA}$ und $f = 900 \text{ MHz}$

$F \leq 9 \text{ dB}$

BA 480

Absolute Grenzwerte: (gültig bis $\vartheta_{J \max}$)

Gleichsperrspannung:	$U_R = \max.$	4 V
Spitzensperrspannung:	$U_{R M} = \max.$	5 V
Durchlaßstrom:	$I_F = \max.$	30 mA
Sperrschichttemperatur:	$\vartheta_J = \max.$	100 °C
Lagerungstemperatur:	$\vartheta_S = \min.$	-65 °C
	$\vartheta_S = \max.$	125 °C

Wärmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Umgebung: $R_{th U} \leq 0,32 \text{ K/mW}$

Kennwerte: bei $\vartheta_U = 25^\circ\text{C}$, sofern nicht anders angegeben

Durchlaßspannung bei $I_F = 1 \text{ mA}$:	$U_F \leq$	280 mV
bei $I_F = 10 \text{ mA}$:	$U_F \leq$	430 mV
Sperrstrom bei $U_R = 4 \text{ V}$:	$I_R \leq$	200 μA
bei $U_R = 4 \text{ V}$ und $\vartheta_U = 60^\circ\text{C}$:	$I_R \leq$	2 mA
Kapazität bei $U_R = 0,2 \text{ V}$ und $f = 1 \text{ kHz}$:	$C \leq$	1,2 pF
Serienwiderstand bei $I_F = 5 \text{ mA}$ und $f = 1 \text{ kHz}$:	$r_f \leq$	15 Ω
Rauschzahl bei $f = 900 \text{ MHz}$: ¹⁾	$F \leq$	9 dB

¹⁾ bei Richtstrom $I_0 = 2 \text{ mA}$ und $F_{ZF} = 1,5 \text{ dB}$ bei $f_{ZF} = 35 \text{ MHz}$

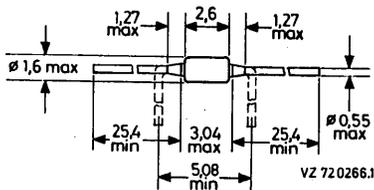
SILIZIUM - EPITAXIAL - SCHOTTKY-BARRIER - DIODE
zur Verwendung als UHF-Mischdiode

Mechanische Daten:

Gehäuse: Glas, JEDEC D0-34

Die Katodenseite ist durch einen Farbring gekennzeichnet.

Maßangaben in mm.



Kurzdaten:

Sperrspannung

$U_R = \text{max. } 4 \text{ V}$

Durchlaßstrom

$I_F = \text{max. } 30 \text{ mA}$

Sperrschichttemperatur

$\vartheta_J = \text{max. } 100 \text{ }^\circ\text{C}$

Rauschzahl bei $I_F = 2 \text{ mA}$ und $f = 900 \text{ MHz}$

$F \leq 8 \text{ dB}$

BA 481

Absolute Grenzwerte: (gültig bis $\vartheta_{J \max}$)

Gleichsperrspannung:

$$U_R = \max. \quad 4 \text{ V}$$

Spitzenperrspannung:

$$U_{RM} = \max. \quad 5 \text{ V}$$

Durchlaßstrom:

$$I_F = \max. \quad 30 \text{ mA}$$

Sperrschichttemperatur:

$$\vartheta_J = \max. \quad 100 \text{ }^\circ\text{C}$$

Lagerungstemperatur:

$$\vartheta_S = \min. \quad -65 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$\vartheta_S = \max. \quad 125 \text{ }^\circ\text{C}$$

Wärmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Umgebung:

$$R_{th U} \leq 0,32 \text{ K/mW}$$

Kennwerte: bei $\vartheta_U = 25^\circ\text{C}$, sofern nicht anders angegeben

Durchlaßspannung bei $I_F = 1 \text{ mA}$:

$$U_F \leq 450 \text{ mV}$$

bei $I_F = 10 \text{ mA}$:

$$U_F \leq 600 \text{ mV}$$

Sperrstrom bei $U_R = 4 \text{ V}$:

$$I_R \leq 10 \text{ } \mu\text{A}$$

bei $U_R = 4 \text{ V}$ und $\vartheta_U = 60^\circ\text{C}$:

$$I_R \leq 100 \text{ } \mu\text{A}$$

Kapazität bei $U_R = 0$ und $f = 1 \text{ MHz}$:

$$C \leq 1,1 \text{ pF}$$

Serienwiderstand bei $I_F = 5 \text{ mA}$ und $f = 1 \text{ kHz}$:

$$r_f \leq 13 \text{ } \Omega$$

Rauschzahl bei $f = 900 \text{ MHz}$: ¹⁾

$$F \leq 8 \text{ dB}$$

¹⁾ bei Richtstrom $I_0 = 2 \text{ mA}$ und $F_{ZF} = 1,5 \text{ dB}$ bei $f_{ZF} = 35 \text{ MHz}$